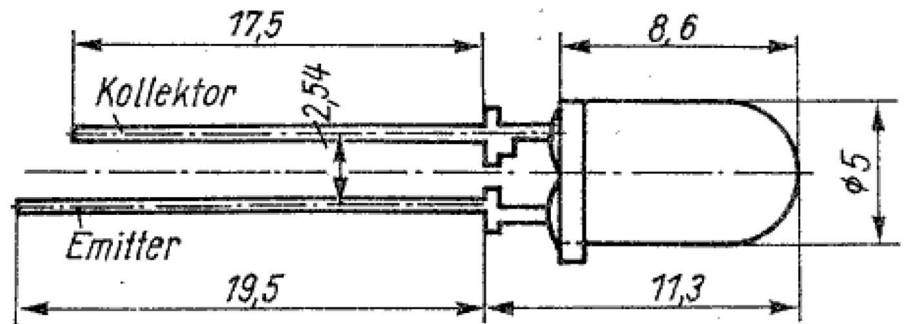


SP 215

Si-npn-Planarfototransistor hoher Fotoempfindlichkeit in 5 mm – Allplast-Linsenverkappung.

Die Basis ist offen, die Steuerung erfolgt durch den Lichteinfall. Die spektrale Empfindlichkeit des SP 215 ist dem Einsatz in Verbindung mit GaAs-IREDD angepaßt.

Bauform 13



Kennwerte bei ϑ_a 25 °C

Kollektor-Emitter-Dunkelstrom

bei $E_e = 0$ lx
 $U_{CE} = 25$ V

I_{CEO}

min

max.

100 nA

Kollektor-Emitterstrom
bei $E_v = 1$ Klx

$U_{CE} = 5$ V

$I_{CE(H)}$

ungruppiert

SP 215 A

SP 215 B

SP 215 C

SP 215 D

1,6

1,6

2,5

4,0

6,3

– mA

3,2 mA

5,0 mA

8,0 mA

– mA

Wellenlänge der max. spektr. Empfindlichkeit

λ_{max}

850

nm

Spektr. Empfindlichkeitsbereich

$\Delta\lambda$

450

1 050

nm

Öffnungswinkel

Θ

30

grad

Schaltzeit

t_r, t_f

10

μs

Kollektor-Emitter-Spannung

U_{CEO}

50

V

Emitter-Kollektor-Spannung

U_{ECO}

7

V

Betriebstemperatur

ϑ_a

–40 ... +85

°C

Lagerungstemperatur

ϑ_{stg}

–50 ... +100

°C